Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевског	ГО
Радиофизический факультет	

Кафедра электроники

Отчёт по лабораторной работе Эффект Холла

Выполнили (430 гр):

Горюнов О.А., Индисов А.И.

Содержание

Teo	ретическая часть	3
1.1	Элементарная теория Эффекта Холла в полупроводниках	3
1.2	Измерительная установка и принципиальная схема	6
Пра	актическая часть	7
2.1	ВАХ образца и измерение паразитного напряжения	7
2.2	Определение типа основных носителей	9
2.3	Определение постоянной Холла, подвижности и концентрации носителей	11
Вы	вол	12
	1.1 1.2 Пра 2.1 2.2 2.3	Практическая часть 2.1 ВАХ образца и измерение паразитного напряжения

Цель работы

Используя Эффект Холла, экспериментально определить тип носителей заряда в образце, постоянную Холла R, концентрацию основных носителей и их подвижность μ .

1 Теоретическая часть

1.1 Элементарная теория Эффекта Холла в полупроводниках

Эффект Холла представляет собой поперечный гальваномагнитный эффект, суть которого заключается в следующем: если поместить полупроводниковую пластину во внешнее магнитное поле \vec{B} (рис. 1) и пропустить вдоль нее ток, создав скрещенное с магнитным электрическое поле, то вследствие смещения движущихся зарядов к одной из граней пластины возникает поперечная разность потенциалов, называемая ЭДС Холла.

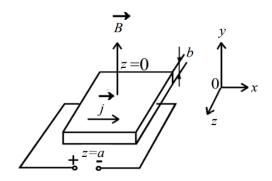
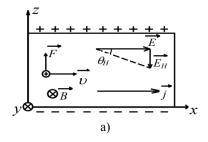


Рис. 1: Схема эксперимента по наблюдению эффекта Холла.



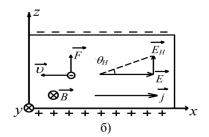


Рис. 2: Смещение основных носителей заряда в дырочном (а) и электронном (б) полупроводниках, соответственно.

Рассмотрим эффект Холла более подробно. На рис. 1 показан полупроводниковый образец, две грани которого подключены через оммические контакты к внешней батарее. Выберем ось x в направлении плотности тока \vec{j} . Магнитное поле \vec{B} при этом пусть будет приложено в направлении оси y. Рассмотрим на примере электрона, движущегося со скоростью \vec{v} . На движущийся в магнитном поле электрон дейтсвует сила Лоренца:

$$\vec{F} = -e[\vec{v}, \vec{B}] \tag{1}$$

где e - абсолютная величина заряда электрона.

В результате действия этой силы тракетория электрона будет искривляться в направлении оси z, и, поскольку в этом направлении ток протекать не может, электроны будут накапливаться на боковой поверхности до тех пор, пока не установится электрическое поле Холла $\vec{E_H}$, достаточное для создания силы, равной силе Лоренца по величине, но противоположной по направлению. Приравнивая эти силы, получим:

$$\vec{E_H} = [\vec{v}, \vec{B}] \tag{2}$$

Закон Ома в диффиренциальной форме:

$$\vec{j} = \sigma \cdot \vec{E} \tag{3}$$

где $\sigma = en\mu$ - удельная электропроводность; n - концентрация электронов, μ_n - их подвижность.

$$\vec{j} = en\mu \cdot \vec{E} = -e \cdot n \cdot \vec{v} \tag{3a}$$

Исключая v из соотношения (2):

$$\vec{E_H} = -\frac{1}{en} \left[\vec{j}, \vec{B} \right] = R \left[\vec{j}, \vec{B} \right] \tag{4}$$

Учитывая, что полный ток через образец I=jab, а поперечная ЭДС $U_H=E_Ha$, получим соотношение:

$$U_H = R \frac{IB}{b} \tag{5}$$

Величина R называется **постоянной Холла** и для полупроводника n-типа определяется как

$$R = -\frac{1}{en} \tag{6}$$

Но это значение не точно, оно не учитывает дрейфовую скорость, которую приобретает электрон под дейтсвием электрического поля, и механизмы рассеивания. В общем виде постоянная Холла может быть записана как:

$$R = -\frac{A}{ne}$$
 для полупроводника n типа (7a)

$$R = \frac{A}{pe}$$
 для полупроводника р типа (7b)

где множитель A может принимать значения от 1 до 1.7.

Знание электропроводности и постоянной Холла позволяет найти как концентрацию носителей, так и их подвижность.

Обозначим через холловский угол ϑ_H малый угол, который образует с осью x вектор напряженности суммарного электрического поля (рис.2):

$$\vartheta_H \approx \operatorname{tg}\vartheta = \frac{E_H}{E} \tag{8}$$

С учётом (3) и (5) получим:

$$\vartheta_H = \mu \cdot B \tag{9}$$

Численное значение холловской подвижности может расходиться с величиной подвижности, определенной другими методами. Определенная таким образом подвижность называется дрейфовой. Её можно определить из выражения (4), если преобразовать его к виду:

$$\vec{E}_H = -\frac{A}{en} \cdot \left[\vec{j}, \vec{B} \right] = -A\mu \cdot \left[\vec{E}, \vec{B} \right] \tag{10}$$

Используя выражения (7а, 7б) можно получить:

$$\mu = R \cdot \sigma \tag{11}$$

1.2 Измерительная установка и принципиальная схема

Приборы и оборудование представлены на рис. 3 ниже.

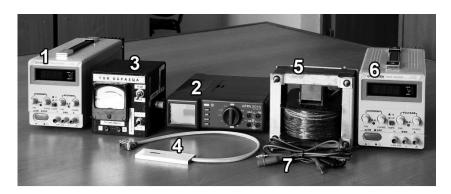


Рис. 3: Оборудование для исследования эффекта Хола: 1 - источник питания образца GPS-3030D, 2 - мультиметр APPA-201N, 3 - согласующий модуль, 4 - исследуемый образец, 5 - электромагнит, 6 - источник питания электромагнита GPS-3030D, 7 - соединительные провода.

Принципиальная схема установки представлена на рис.4 ниже:

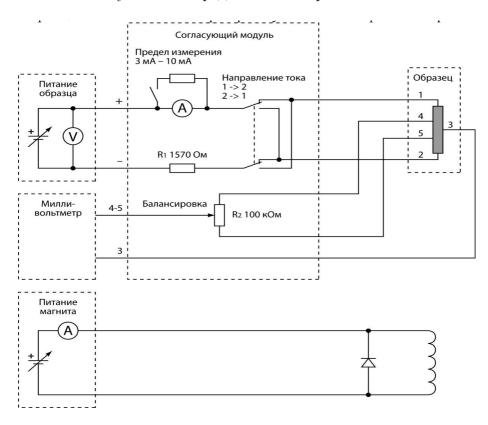


Рис. 4: Принципиальная схема лабораторной установки.

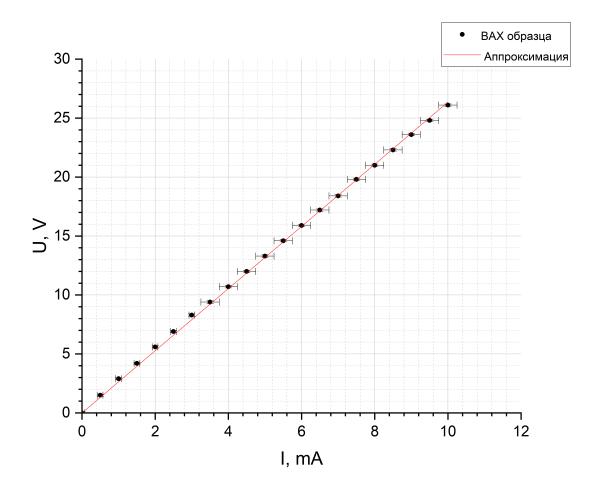
2 Практическая часть

2.1 ВАХ образца и измерение паразитного напряжения

Определить удельное сопротивление образца (а следовательно и проводимость) можно сняв его ВАХ. Т.е. измерения проводились с выключенным магнитным полем. Используя закон Ома:

$$U = I \cdot R$$

т.е. R определяется как коэффициент наклона прямой.



Погрешность напряжения определялась по цене деления источника ($\Delta U = 0, 1 \text{ мB}$), а погрешность тока образца по классу точности (=2.5).

Из графика:

$$R \approx 2635 \ \mathrm{Om}$$

А погрешность оценим по максимальному и минимальному наклону прямой, проходящей через погрешности:

$$R_{max} \approx 2684 \text{ Om}, \ R_{min} \approx 2544 \text{ Om}$$

 $\Rightarrow R \approx (2635 \pm 91) \text{ Om}; \quad (\delta R = 3, 5\%)$

Но нужно учесть, что в цепь с образцом последовательно включен резистор $R_1=1570~{\rm Om}.$ Тогда искомое сопротивление образца:

$$R_{\rm obp} \equiv R = (1065 \pm 91) \text{ Om}$$

Размеры образца указаны на рис.5. a=22 мм, b=1,9 мм, d=0,33 мм. Тогда по определению удельного сопротивления:

$$\rho = \frac{R \cdot b \cdot d}{a} \approx (0,0304 \pm 0,0011) \text{ Om} \cdot \text{m}$$

$$\Rightarrow \sigma = \frac{1}{\rho} \approx (32,895 \pm 1,151) \text{ Om}^{-1} \text{m}^{-1}$$

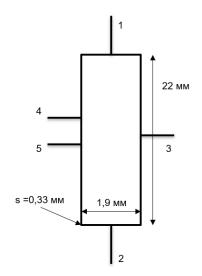


Рис. 5: Размеры образца.

При подсоединении измерительных контактов к образцу невозможно их расположить абсолютно точно друг напротив друга, в результате чего между этими выводами появится паразитная разность потенциалов, обусловленная током образца, которая будет давать систематическую аддитивную ошибку измерения ЭДС Холла. Чтобы её уменьшить, с одной из сторон делаются два контакта (4 и 5), к которым подсоединяются крайние выводы переменного резистора R_2 . Изменяя положение движка резистора R_2 , можно найти точку с потенциалом, равным потенциалу контакта 3.

Для того чтобы исключить паразитную разность потенциалов в дальнейшем, сняли, как $U_{\rm n}$ зависит от тока образца. И далее просто будем её вычитать из снятых значений \mathscr{E}_H при включенном магнитном поле.

2.2 Определение типа основных носителей

Ток подавался от контакта 1 к 2. При этом во внешнем магнитном поле, мультиметр снимал разность потенциалов $U_H = \phi_3 - \phi_4 5$, при этом $U_H > 0$. Это говорит о том, что со стороны контакта 3 копиться положительный заряд, а со стороны 4-5 отрицательный. Предположим, что движется дырка. Тогда на неё будет действовать сила Лоренца:

$$F_{\scriptscriptstyle \rm I\hspace{-1pt}I}=q[\vec{v},\vec{B}]$$

Сила будет как раз отклонять частицы к 3 контакту. Если предположить, что двигается электрон, то его скорость будет противонаправлена \vec{E} . И так как заряд электрона отрицательный, сила Лоренца будет так же направлена к клемме 3. И там бы копился отрицательный заряд.

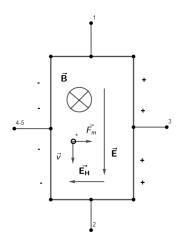


Рис. 6: Размеры образца.

Основной тип носителей заряда - дырки.

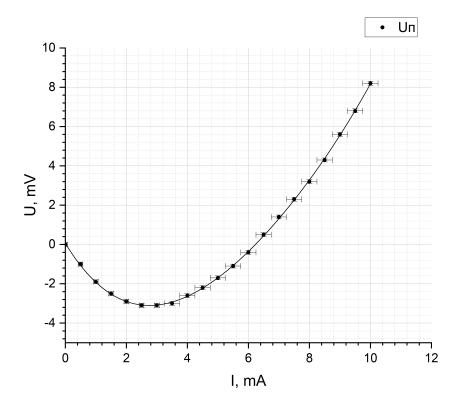


Рис. 7: Зависимость $U_{\rm n}$ от $I_{\rm oбp}$.

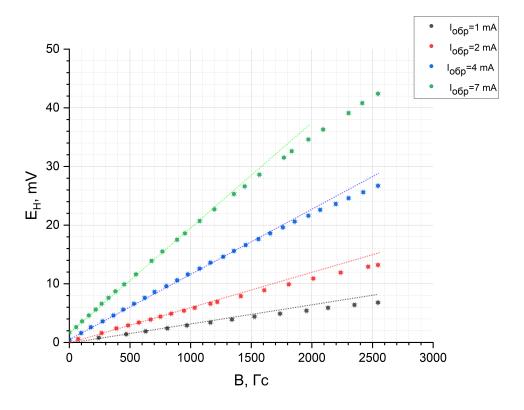


Рис. 8: Зависимость \mathscr{E}_H от B.

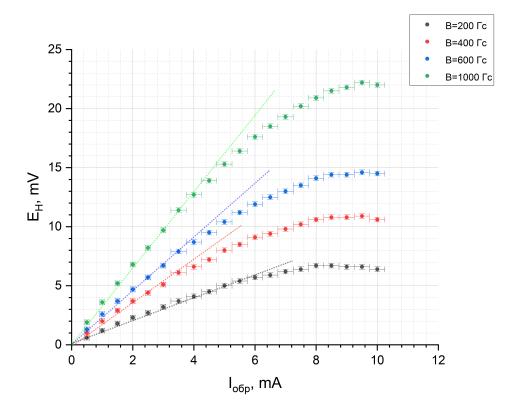


Рис. 9: Зависимость \mathscr{E}_H от $I_{\text{обр}}$.

2.3 Определение постоянной Холла, подвижности и концентрации носителей

Согласно формуле (5), коэффициент Холла можно определить как:

$$R = \frac{U_H \cdot b}{I_{\text{obp}} B}$$

По графикам его можно определить по коэффициенту наклона (на линейном участке). Рассмотрим все зависимости отдельно и определим для них постоянную Холла:

При постоянном токе:

$$I_{\rm o6p} = 1 \text{ MA}: R_1 \approx 6,06 \cdot 10^{-4} \frac{\rm OM \cdot cM}{\Gamma c}; I_{\rm o6p} = 2 \text{ MA}: R_2 \approx 5,34 \cdot 10^{-4} \frac{\rm OM \cdot cM}{\Gamma c};$$

$$I_{\rm o6p} = 4 \text{ MA}: R_3 \approx 5,52 \cdot 10^{-4} \frac{\rm OM \cdot cM}{\Gamma c}; I_{\rm o6p} = 4 \text{ MA}: R_4 \approx 4,88 \cdot 10^{-4} \frac{\rm OM \cdot cM}{\Gamma c};$$

При фиксированной магнитной индукции:

$$B = 200 \ \Gamma c: \ R_5 \approx 9,43 \cdot 10^{-4} \ \frac{O_{\rm M} \cdot c_{\rm M}}{\Gamma c}; \ B = 400 \ \Gamma c: \ R_6 \approx 8,62 \cdot 10^{-4} \ \frac{O_{\rm M} \cdot c_{\rm M}}{\Gamma c};$$
$$B = 600 \ \Gamma c: \ R_7 \approx 7,25 \cdot 10^{-4} \ \frac{O_{\rm M} \cdot c_{\rm M}}{\Gamma c}; \ B = 1000 \ \Gamma c: \ R_8 \approx 6,17 \cdot 10^{-4} \ \frac{O_{\rm M} \cdot c_{\rm M}}{\Gamma c};$$

Тогда среднее значение (включая погрешность $\delta R \sim 20\%$):

$$R_{\rm cp} \approx (6, 66 \pm 1, 33) \cdot 10^{-4} \frac{\rm O_M \cdot c_M}{\Gamma c}$$

Или в СИ:

$$R_{\rm cp} \approx (6,66 \pm 1,33) \cdot 10^{-2} \frac{{\rm O_{M} \cdot {\rm M}}}{{\rm T_{\Pi}}}$$

Тогда подвижность основных носителей заряда:

$$\mu = R_{\rm cp} \cdot \sigma \approx 2,19 \left[\frac{1}{{\rm T}_{\rm J}} \right] \equiv 2,19 \left[\frac{{\rm M}^2}{{\rm B} \cdot {\rm c}} \right]$$
$$\delta \mu = \delta \sigma + \delta R \approx 23,5\%$$

Концентрацию носителей можно оценить по формуле:

$$R_{\rm cp} \approx \frac{1}{p \cdot e} \Rightarrow p \approx \frac{1}{R_{\rm cp} \cdot e}$$

$$p \sim 10^{20} \; [{\rm M}^{-3}]$$

3 Вывод

Выполнив лабораторную работу, мы:

1) Определили удельную проводимость образца:

$$\sigma = \approx (32,895 \pm 1,151) \text{ Om}^{-1} \text{M}^{-1}$$

2) По графикам определили значения постоянной Холла. Среднее значение:

$$R_{\rm cp} \approx (6, 66 \pm 1, 33) \cdot 10^{-2} \frac{{\rm O_M \cdot M}}{{\rm T_{\rm II}}}$$

3) Оценили подвижность основных носителей в образце и их концентрацию:

$$\mu \approx (2, 19 \pm 0, 51) \left[\frac{\text{M}^2}{\text{B} \cdot \text{c}} \right]$$

$$p \sim 10^{20} \text{ [M}^{-3} \text{]}$$